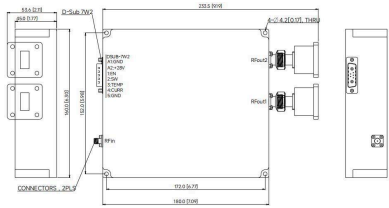


10700–12750 MHz GaN RF 전력 증폭기, 전형 100 W, WR75 어댑터

GaN 증폭기는 10700–12750 MHz에서 전형 포화 출력 100 W와 최소 이득 50 dB를 제공합니다. 1 dB 압축점의 전형 출력은 40 W, 100 W에서 전형 전류는 21 A입니다.



전기 사양 · +28.0VDC; 25°C; 50Ω

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	BW	10700	-	12750	MHz
1 dB 압축점 출력 전력	P-1dB	-	40	-	W
RF 출력 전력 @ PSAT	PSAT	-	100	-	W
전력 이득 @ PSAT	Gp	50	-	-	dB
전력 이득 평탄도 @ PSAT	ΔGp	-	±1	-	dB
입력 반사 손실	S11	-	-15	-	dB
100 W 조건의 고조파	H	-	-20	-	dBc
스퓨리어스 신호 @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
입출력 임피던스	Impedance	-	50	-	Ω
동작 전압	VDC	-	28	-	VDC
전력 부가 효율 @ 100W	Eff	-	25	-	%
DC 전류 @ 100W	IDD	-	21	-	A

절대 최대 정격

항목	정격
손상이 발생하지 않는 RF 입력 전력	+10 dBm 최대
Pout = 100 W 조건의 부하 VSWR	∞; 모든 부하 위상 및 진폭, 연속
열 과부하	85 °C → 정지 (최대)

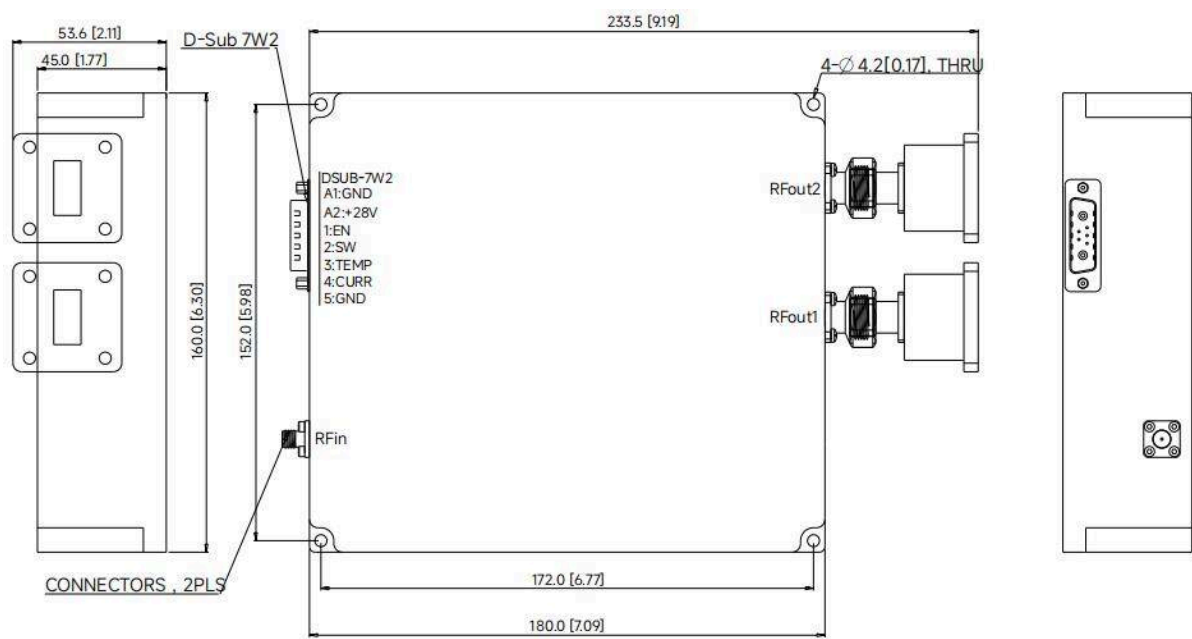
환경 사양 · 설계 목표; 프로젝트별 확인 필요

항목	최솟값	일반값	최댓값	단위	비고
동작 온도	-20	-	50	°C	-
보관 온도	-25	-	65	°C	보관 온도
상대 습도(비응축)	-	-	95	%	-

기구 사양 · 원표는 최대180 × 160 × 45 mm로 표시하며 원본 CAD에는 도면의 본체를 넘는 전체 치수233.5 mm와53.6 mm도 있습니다. 최대 외형의 적용 범위가 확정되지 않아 확인이 필요합니다. 원표는 핀 5를 VSWR 경보에 할당하지만 원본 CAD는 GND로 표시합니다. 해당 할당은 보류하며 배선 확인이 필요합니다.

항목	값	단위
중량	2.5 kg (최대)	kg
RF 입력 커넥터	SMA, 암	-
RF 출력 커넥터	N-K → WR75 도파관 어댑터	-
DC/제어 인터페이스	하이브리드, D-Sub 7, 수	-

기구 외형도



모든 치수의 단위는 mm [in]입니다.

DC 및 제어 인터페이스

핀 번호	설명	사양
A1	A1 — 접지	접지
A2	A2 — 전원 양극	+28V
1	1 — 활성화	TTL High 레벨(3.3 V), 내부 풀다운
2	2 — RF 채널 선택 (SW)	CH1: Low 레벨; CH2: High 레벨; <15 ms
3	3 — 온도 감지 출력	750 ±20 mV @25 °C; 10 mV/°C
4	4 — 전류 감지 출력	100 mV/A

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.